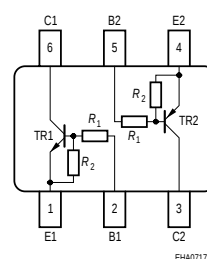
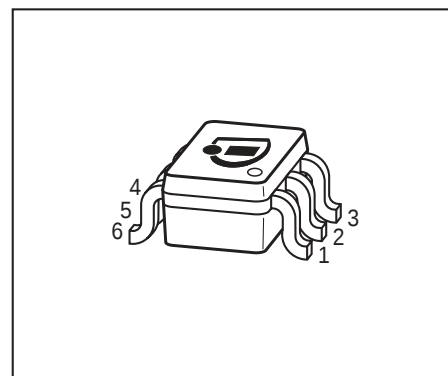
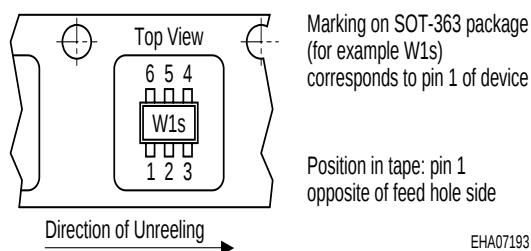


NPN/PNP Silicon Digital Transistor Array

- Switching circuit, inverter, interface circuit, driver circuit
- Two (galvanic) internal isolated NPN/PNP Transistors in one package
- Built in bias resistor NPN and PNP ($R_1=10\text{ k}\Omega$, $R_2=47\text{ k}\Omega$)
- Pb-free (ROHS compliant) package¹⁾
- Qualified according AEC Q101



Tape loading orientation



Type	Marking	Pin Configuration						Package
BCR35PN	WUs	1=E1	2=B1	3=C2	4=E2	5=B2	6=C1	SOT363

Maximum Ratings for NPN and PNP Types

Parameter	Symbol	Value	Unit
Collector-emitter voltage	V_{CEO}	50	V
Collector-base voltage	V_{CBO}	50	
Input forward voltage	$V_{i(fwd)}$	40	
Input reverse voltage	$V_{i(rev)}$	6	
DC collector current	I_C	100	mA
Total power dissipation, $T_S = 115\text{ }^\circ\text{C}$	P_{tot}	250	mW
Junction temperature	T_j	150	$^\circ\text{C}$
Storage temperature	T_{stg}	-65 ... 150	

Thermal Resistance

Junction - soldering point ²⁾	R_{thJS}	≤ 140	K/W
--	------------	------------	-----

¹⁾Pb-contain package may be available upon special request

²⁾For calculation of R_{thJA} please refer to Application Note Thermal Resistance

Electrical Characteristics at $T_A=25^{\circ}\text{C}$, unless otherwise specified

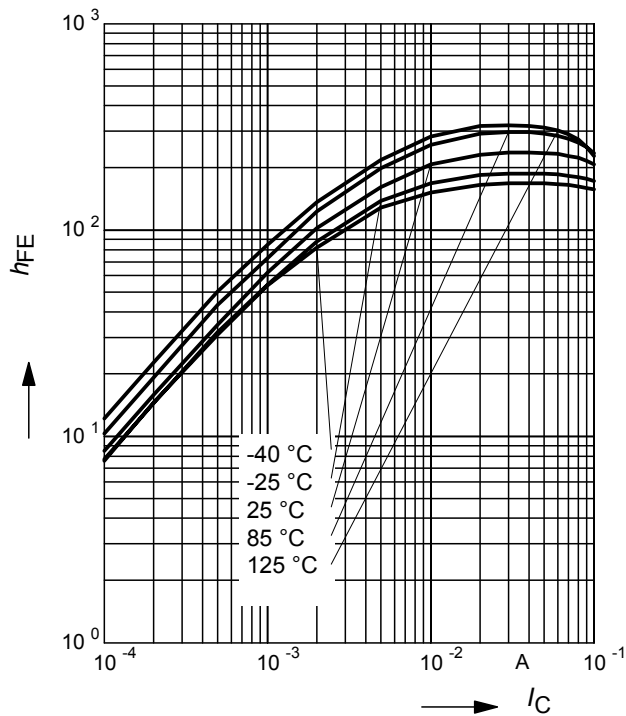
Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
DC Characteristics for NPN and PNP Types					
Collector-emitter breakdown voltage $I_C = 100\text{ }\mu\text{A}$, $I_B = 0$	$V_{(BR)CEO}$	50	-	-	V
Collector-base breakdown voltage $I_C = 10\text{ }\mu\text{A}$, $I_E = 0$	$V_{(BR)CBO}$	50	-	-	
Collector cutoff current $V_{CB} = 40\text{ V}$, $I_E = 0$	I_{CBO}	-	-	100	nA
Emitter cutoff current $V_{EB} = 6\text{ V}$, $I_C = 0$	I_{EBO}	-	-	167	μA
DC current gain 1) $I_C = 5\text{ mA}$, $V_{CE} = 5\text{ V}$	h_{FE}	70	-	-	-
Collector-emitter saturation voltage1) $I_C = 10\text{ mA}$, $I_B = 0.5\text{ mA}$	V_{CEsat}	-	-	0.3	V
Input off voltage $I_C = 100\text{ }\mu\text{A}$, $V_{CE} = 5\text{ V}$	$V_{i(off)}$	0.5	-	1	
Input on Voltage $I_C = 2\text{ mA}$, $V_{CE} = 0.3\text{ V}$	$V_{i(on)}$	0.5	-	1.4	
Input resistor	R_1	7	10	13	k Ω
Resistor ratio	R_1/R_2	0.19	0.21	0.24	-
AC Characteristics for NPN and PNP Types					
Transition frequency $I_C = 10\text{ mA}$, $V_{CE} = 5\text{ V}$, $f = 100\text{ MHz}$	f_T	-	150	-	MHz
Collector-base capacitance $V_{CB} = 10\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$	C_{cb}	-	2	-	pF

1) Pulse test: $t < 300\mu\text{s}$; $D < 2\%$

NPN Type

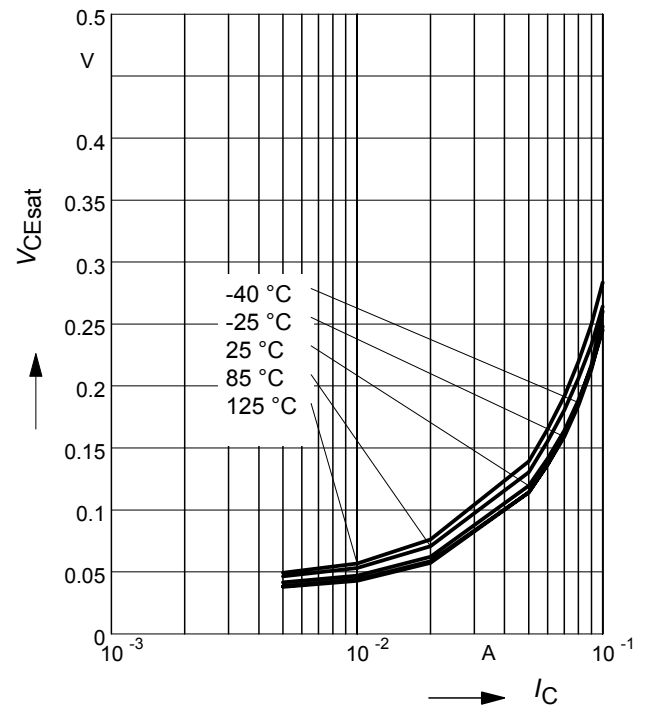
DC Current Gain $h_{FE} = f(I_C)$

$V_{CE} = 5V$ (common emitter configuration)



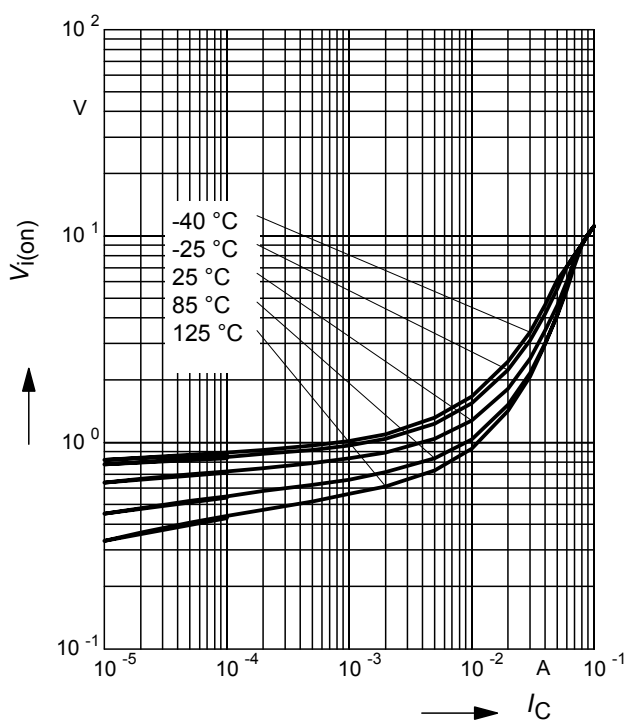
Collector-Emitter Saturation Voltage

$V_{CEsat} = f(I_C), h_{FE} = 20$



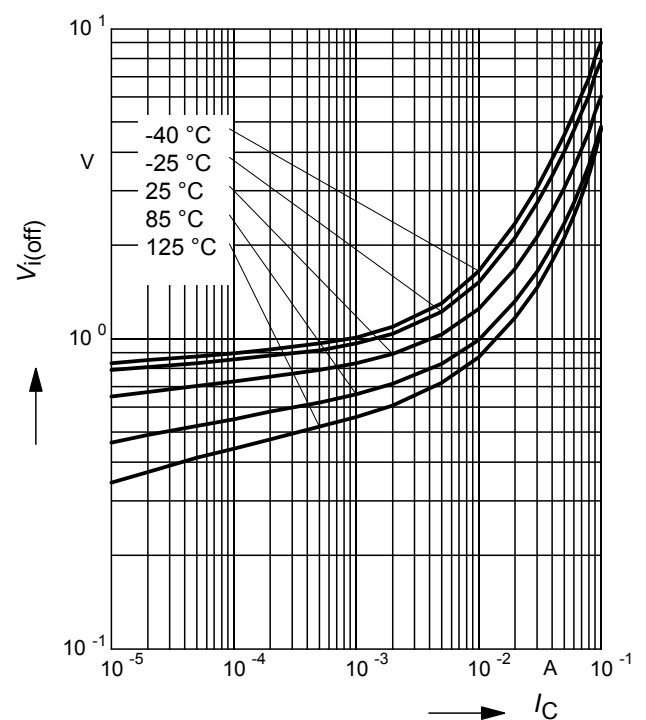
Input on Voltage $V_{i(on)} = f(I_C)$

$V_{CE} = 0.3V$ (common emitter configuration)



Input off voltage $V_{i(off)} = f(I_C)$

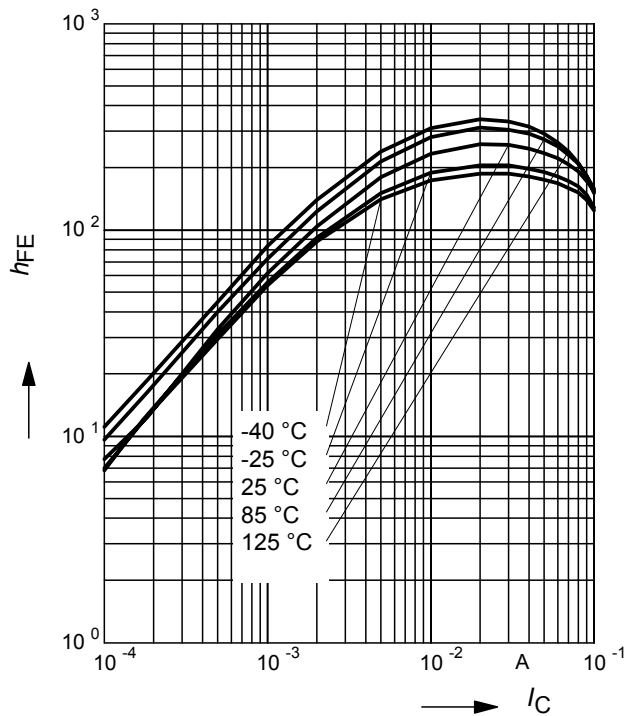
$V_{CE} = 5V$ (common emitter configuration)



PNP Type

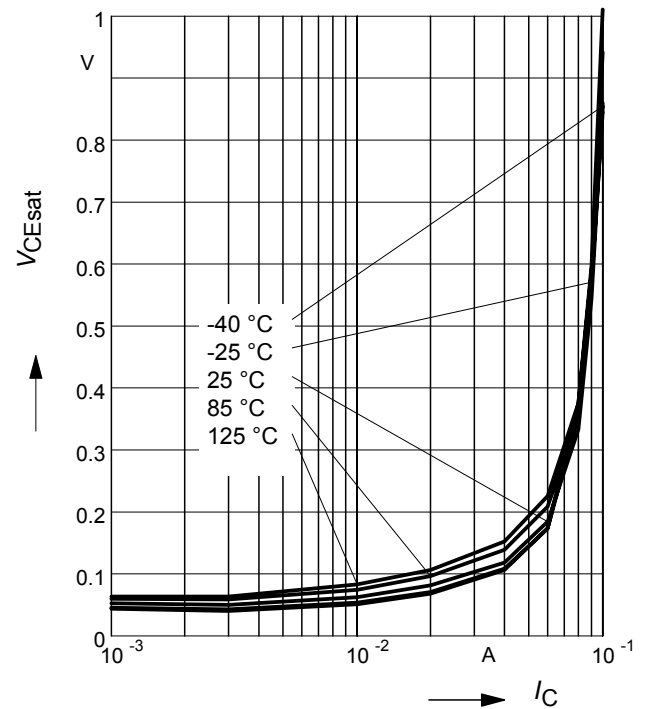
DC Current Gain $h_{FE} = f(I_C)$

$V_{CE} = 5V$ (common emitter configuration)



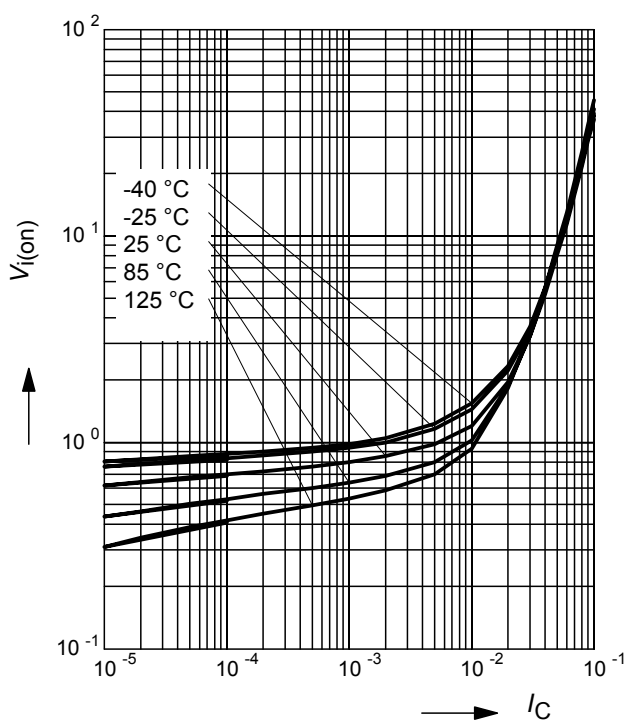
Collector-Emitter Saturation Voltage

$V_{CEsat} = f(I_C), h_{FE} = 20$



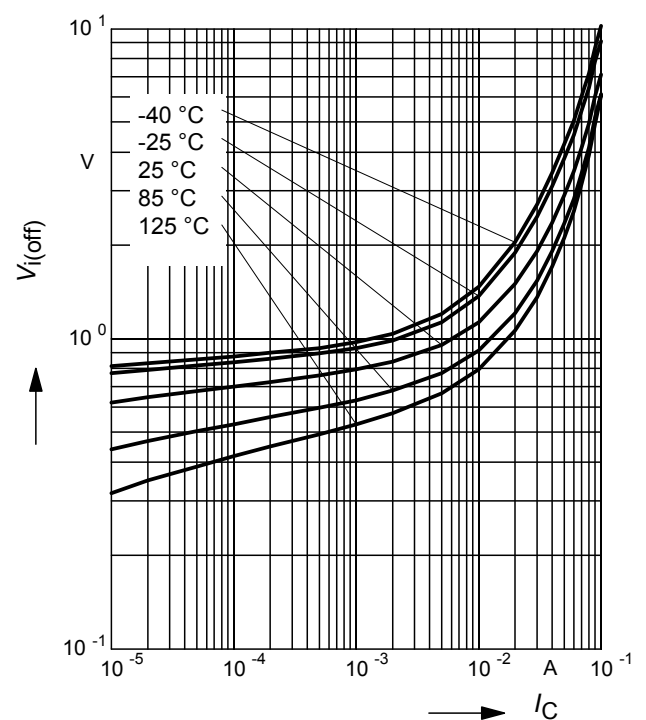
Input on Voltage $V_{i(on)} = f(I_C)$

$V_{CE} = 0.3V$ (common emitter configuration)

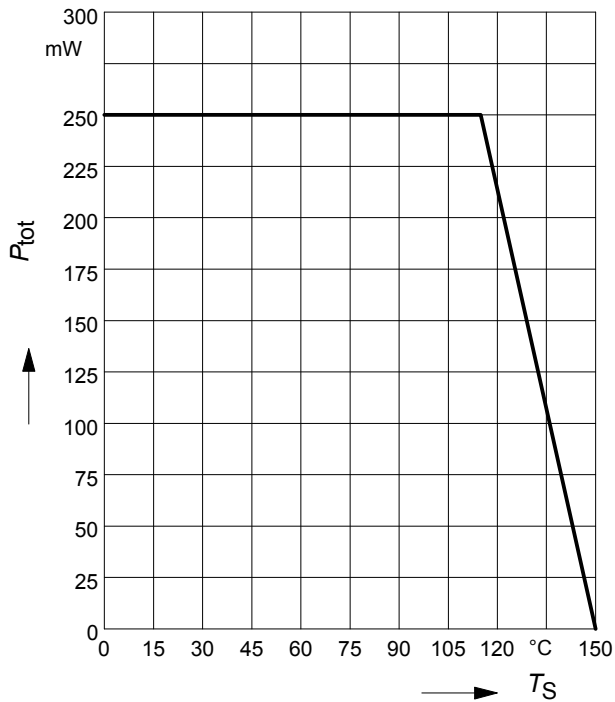


Input off voltage $V_{i(off)} = f(I_C)$

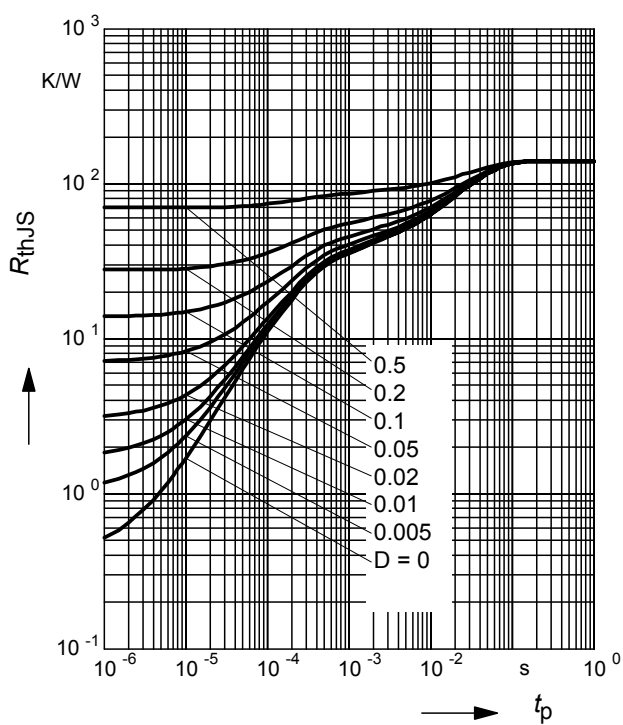
$V_{CE} = 5V$ (common emitter configuration)



Total power dissipation $P_{\text{tot}} = f(T_S)$



Permissible Pulse Load $R_{\text{thJS}} = f(t_p)$



Permissible Pulse Load

$P_{\text{totmax}} / P_{\text{totDC}} = f(t_p)$

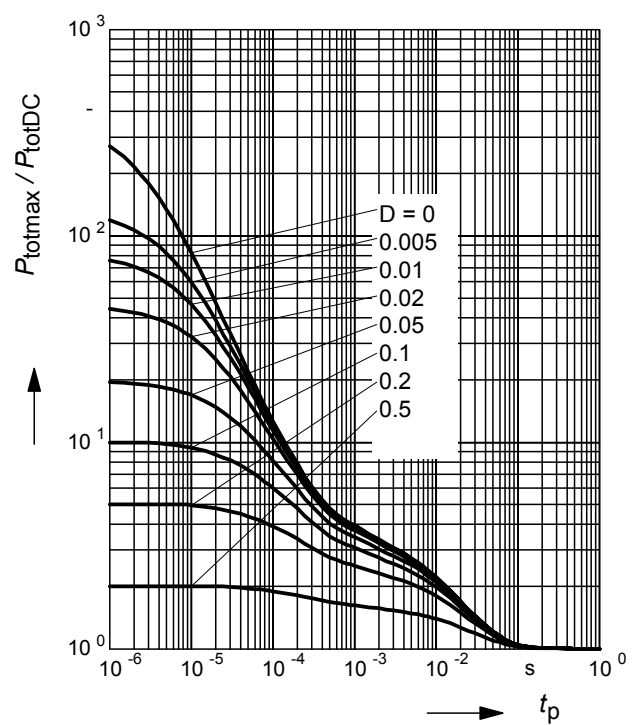


Diagram illustrating the marking on the BCR108S component:

- Manufacturer:** Infineon Technologies
- Date code (Year/Month):** 2005, June
- Type code:** BCR108S
- Pin 1 marking:** Laser marking (indicated by a circle on the bottom-left pin)

Technical drawing of a PCB layout for a 3-pin connector. The top view shows a rectangular board with dimensions 4 (width) and 8 (height). Three circular pins are spaced 2.15 apart. A 2.3x2.3 square area is marked. A side view shows a 0.2 thick board with a 1.1 high component.

Published by
Infineon Technologies AG
81726 München, Germany
© Infineon Technologies AG 2007.
All Rights Reserved.

Attention please!

The information given in this data sheet shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics ("Beschaffenheitsgarantie"). With respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

Information

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices please contact your nearest Infineon Technologies Office (www.infineon.com).

Warnings

Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your nearest Infineon Technologies Office.

Infineon Technologies Components may only be used in life-support devices or systems with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect the safety or effectiveness of that device or system.

Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body, or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>